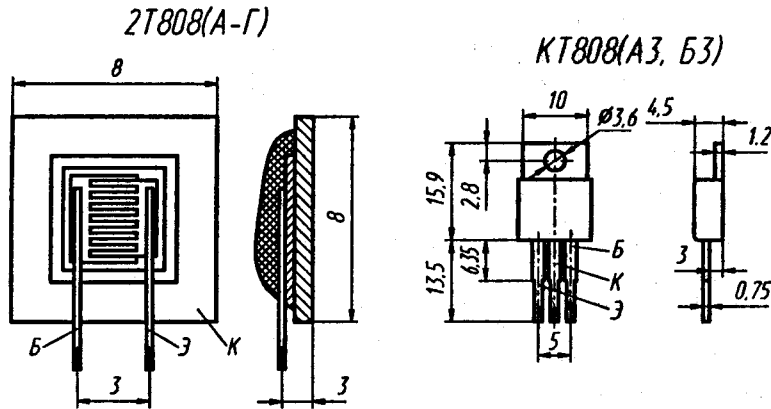


**2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ, КТ808БМ,
КТ808ВМ, КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ**

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ-КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами, КТ808АЗ, КТ808БЗ — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ-КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г, КТ808АЗ, КТ808БЗ — не более 2,5 г.

Изготовитель — завод «Искра», г. Ульяновск.

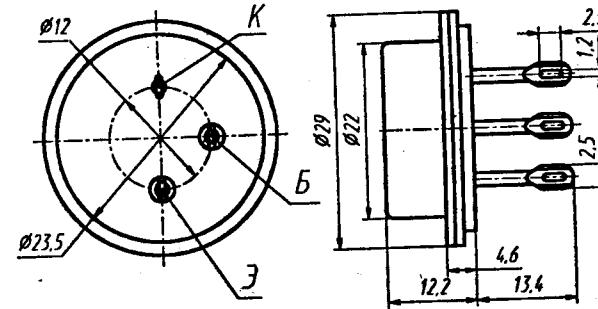


Электрические параметры

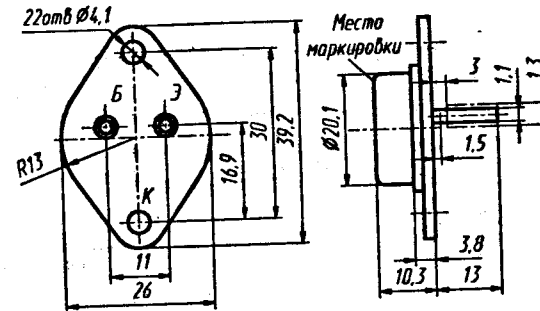
Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при $U_{кэ} = 3$ В,
 $I_k = 6$ А:
 $T = +25$ °С 10...15*...50

2Т808А, КТ808А



КТ808(АМ-ГМ)



$T = +125$ °С для 2Т808А и $T = +100$ °С для КТ808А	10...20*...150
$T = -60$ °С	6...10*...50
КТ808АМ-КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 2$ А	20...125
Модуль коэффициента передачи тока на вы- сокой частоте $f = 3,5$ МГц при $U_{кэ} = 10$ В, $I_э = 0,5$ А, не менее	2,4
Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А, $L = 25$ мГн, не менее:	
КТ808АМ, КТ808АЗ	130 В
КТ808БМ, КТ808БЗ	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ808АМ-КТ808ГМ при $I_k = 6$ А, $I_э = 0,6$ А, не более	1,5 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 6$ А, $I_b = 0,6$ А	1*...1,4*... 2,5 В
Время рассасывания при $U_{кэ} = 15$ В, $I_k = 6$ А, не более	2 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 10$ Ом, не более: $T = +25$ и -60 °С и $U_{кэ} = 200$ В для 2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ} = 120$ В для КТ808А	3 мА
$T = +125$ °С, $U_{кэ} = 160$ В для 2Т808А, 2Т808А-2	20 мА
$T = +100$ °С $U_{кэ} = 120$ В для КТ808А	50 мА
Обратный ток коллектора КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ при $U_{кэ} = U_{кэ R, \text{МАКС}}$, $T = +25$ °С, не более	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 4$ В, не более	15 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, $f = 1$ МГц, не более	500 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{бэ} = 10$ Ом, $T_n \leq 100$ °С	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	120 В
КТ808АМ, КТ808АЗ	130 В
КТ808БМ, КТ808БЗ	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $t_n \leq 500$ мкс, $t_p \geq 30$ мкс, $U_{бэ} = 2$ В или $R_{бэ} = 10$ Ом, $Q \geq 7$, $T_n \leq +100$ °С:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ	250 В
КТ808БМ	160 В
КТ808ВМ	135 В
КТ808ГМ	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	4 В
КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	15 А

¹ При $T_n = +100...150$ °С постоянное и импульсное напряжение коллектор—эмиттер снижаются на 10% на каждые 10 °С. Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_n + R_{T(n-k)}(P_k + P_3), \text{ °С.}$$

Постоянный ток базы	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = -60...+50$ °С: с теплоотводом:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	50 Вт
КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ	70 Вт
без теплоотвода 2Т808А, КТ808А	5 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	2 °С/Вт
Температура $p-n$ перехода	+150 °С
Температура окружающей среды:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808АМ—КТ808ГМ ...	$-60...T_k =$ $= +125$ °С
КТ808А, КТ808АЗ, КТ808БЗ	$-60...T_k =$ $= +100$ °С

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А-2 не более +250 °С, 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ—КТ808ГМ не более +275 °С в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А-2 составляет 300 В.